

# ВЛИЯНИЕ КУЛОНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МЕЖЗОННЫЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Г. В. Будкин \*, Е. Л. Ивченко \*\*

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук  
194021, Санкт-Петербург, Россия

Поступила в редакцию 6 сентября 2024 г.,  
после переработки 6 сентября 2024 г.  
Принята к публикации 8 октября 2024 г.

В рамках одной модели зонной структуры нецентросимметричного полупроводника рассчитаны баллистический и сдвиговый вклады в межзонный линейный фотогальванический эффект. В расчете использован двухзонный обобщенный дираковский эффективный гамильтониан с недиагональными компонентами, содержащими слагаемые первого и второго порядков по волновому вектору. Развитая теория учитывает кулоновское взаимодействие между фотовозбужденными электроном и дыркой. Показано, что в типичных полупроводниках баллистический фототок  $j^{(bal)}$  существенно превышает сдвиговый ток  $j^{(sh)}$ : отношение  $j^{(sh)}/j^{(bal)}$  имеет порядок  $a_B/\ell$ , где  $a_B$  — боровский радиус,  $\ell$  — длина свободного пробега фотоносителей, обусловленная их рассеянием по квазиимпульсу.

DOI: 10.31857/S0044451025020130

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Под воздействием переменного электромагнитного поля в макроскопически однородных кристаллах или латерально однородных двумерных полупроводниковых структурах без центра пространственной инверсии могут возникать постоянные фототоки. Такие явления принято называть фотогальваническими эффектами. Цель данной работы — в рамках единой модели зонной структуры полупроводника рассчитать баллистический и сдвиговый вклады в линейный фотогальванический эффект (ЛФГЭ) при учете кулоновского взаимодействия между фотовозбужденными электроном и дыркой и сопоставить эти вклады между собой. Первый вклад обусловлен асимметрией распределения фотоносителей заряда в пространстве квазиимпульсов [1–3], а второй возникает за счет смещения волновых пакетов электронов в реальном пространстве при оптических переходах [4–6]. Важной особенностью ЛФГЭ является то, что при прямых оптических переходах без учета дополнительного рассея-

ния электрон-дырочной пары баллистический вклад не возникает, например, необходим учет рассеяния электрона и дырки друг на друге (кулоновский вклад), на колебаниях решетки (фононный вклад), на дефектах решетки или на других носителях заряда. Мы поставили перед собой задачу устранить имеющееся противоречие в оценках относительной роли баллистического и сдвигового фототоков,  $j^{(bal)}$  и  $j^{(sh)}$  соответственно, генерируемых при оптических переходах между валентной зоной и зоной проводимости. В специальной методической заметке [7] указано, что при межзонных переходах баллистический вклад в ЛФГЭ является доминирующим. Напротив, в опубликованных позднее работах [8, 9] утверждается, что баллистический ток, возникающий при учете кулоновского взаимодействия электрона и дырки, существенно меньше сдвигового вклада. Указанное противоречие, а также наличие большого числа работ, посвященных расчету только сдвигового вклада в ЛФГЭ, см., например, [10–24], и вызывает необходимость рассмотрения обоих вкладов в фототок для одной и той же конкретной модели зонной структуры полупроводника.

В настоящей работе электрон-дырочное кулоновское взаимодействие учитывается при рассмотрении как баллистического, так и сдвигового фототоков.

\* E-mail: budkin@mail.ioffe.ru

\*\* E-mail: ivchenko@coherent.ioffe.ru

Первая работа по точному учету этого взаимодействия при расчете тока  $j^{(bal)}$  опубликована сорок пять лет назад [25]. В отличие от этой работы мы принимаем во внимание, что матричные элементы оператора скорости, рассчитанные на кулоновских функциях непрерывного спектра  $\psi_{\mathbf{k}'}^{(+)}$  и  $\psi_{\mathbf{k}}^{(+)}$  [20], имеют недиагональные компоненты по  $\mathbf{k}'$  и  $\mathbf{k}$ . Здесь также впервые выводится аналитическое выражение для сдвигового фототока при учете кулоновского взаимодействия. Ранее такой учет сводился только к записи сдвигового фототока в виде суммы общего вида без преобразования ее к аналитической формуле, содержащей параметры зонной структуры материала [19].

## 2. ДИРАКОВСКИЙ ГАМИЛЬТониАН В ПОЛУПРОВОДНИКЕ БЕЗ ЦЕНТРА ИНВЕРСИИ

Мы используем модель двухзонной электронной структуры полупроводника тетраэдрической симметрии  $T_d$  со спиновыми базисными функциями в  $\Gamma$ -точке, преобразующимися по представлениям  $\Gamma_6$  в зоне проводимости и  $\Gamma_7$  в валентной зоне. Эти базисные функции выражаются через блоховские орбитальные функции  $S, X, Y, Z$  и спиновые столбцы  $\alpha, \beta$  (с проекцией спина  $+1/2$  и  $-1/2$  на ось  $z \parallel [001]$ ) в следующей форме:

$$\begin{aligned} \psi_{\Gamma_6, 1/2} &= i\alpha S, \psi_{\Gamma_6, -1/2} = i\beta S, \\ \psi_{\Gamma_7, 1/2} &= -\frac{1}{\sqrt{3}}[\alpha Z + \beta(X + iY)], \\ \psi_{\Gamma_7, -1/2} &= \frac{1}{\sqrt{3}}[\beta Z - \alpha(X - iY)]. \end{aligned} \quad (1)$$

В этом базисе обобщенный дираковский гамильтониан принимает вид [27, 28]

$$\hat{H}_0 = \begin{pmatrix} E_g/2 & P\sigma\mathbf{k} + iQ\sigma\boldsymbol{\pi} \\ P\sigma\mathbf{k} - iQ\sigma\boldsymbol{\pi} & -E_g/2 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где  $P$  — вещественный зонный параметр  $(i\hbar/\sqrt{3}m_0)\langle S|\hat{p}_x|X\rangle$ , вектор  $\boldsymbol{\pi} = (k_y k_z, k_x k_z, k_x k_y)$ , декартовы координаты  $x, y, z$  направлены по кристаллографическим осям  $[100]$ ,  $[010]$  и  $[001]$  соответственно,  $\boldsymbol{\sigma}$  — трехмерный псевдовектор, компонентами которого являются матрицы Паули; недиагональные слагаемые, квадратичные по  $\mathbf{k}$  и определяемые зонным параметром  $Q$ , описывают инверсионную асимметрию, они возникают за счет вклада далеких зон в процедуру Лёвдина [29], позволяющей свести многозонный гамильтониан к матрице (2) размерности  $4 \times 4$ .

Мы рассматриваем оптические переходы вблизи запрещенной зоны  $E_g$  и считаем, что частота света  $\omega$  удовлетворяет неравенству

$$\hbar\omega - E_g \ll E_g. \quad (3)$$

В этом случае достаточно ограничиться параболической дисперсией электронов в зоне проводимости  $c$  и валентной зоне  $v$ :

$$\varepsilon_{c\mathbf{k}} = -\varepsilon_{v\mathbf{k}} \equiv \varepsilon_{h\mathbf{k}} = \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}, \quad (4)$$

где одночастичная эффективная масса  $m^* = \hbar^2 E_g/2P^2$ , а приведенная масса электрона и дырки  $\mu = m^*/2$ . Заметим однако, что рассматриваемый здесь фототок пропорционален зонному параметру асимметрии  $Q$ , который будет учтен в матричных элементах межзонных переходов.

### 2.1. Электрон-дырочные состояния в континууме

В методе эффективной массы двухчастичную волновую функцию электрона и дырки с нулевым квазиимпульсом трансляционного движения можно представить в общем виде как

$$\Psi_{s_e, s_h} = \psi(\mathbf{r})u_{\Gamma_6, s_e}(\mathbf{r}_e)u_{\Gamma_7, s_h}^{(h)}(\mathbf{r}_h). \quad (5)$$

Здесь  $\psi(\mathbf{r})$  — плавная огибающая функция разностной переменной  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h$ ,  $u_{\Gamma_6, s_e}(\mathbf{r}_e)$  и  $u_{\Gamma_7, s_h}^{(h)}(\mathbf{r}_h) = -Ku_{\Gamma_7, -s_h}(\mathbf{r}_h)$  — блоховские периодические амплитуды для электрона и дырки в точке экстремума  $\mathbf{k} = 0$ ,  $s_e$  и  $s_h$  — проекции спина  $\pm 1/2$  на направление оси  $z$ ,  $K$  — оператор инверсии времени, связывающий состояния в электронном и дырочном представлениях:  $K = -i\sigma_y K_0$ ,  $\sigma_y$  — матрица Паули,  $K_0$  — оператор комплексного сопряжения. Поскольку энергии (4) не зависят от спиновых состояний, плавная огибающая тоже не зависит от индексов  $s_e, s_h$ . Для удобства в дальнейшем нормировочный объем кристалла  $V$  положим равным единице.

В качестве собственных состояний кулоновской задачи  $\Psi_{s_e, s_h, \mathbf{k}} \equiv |s_e, s_h, \mathbf{k}\rangle$  мы используем огибающие  $\psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r})$ , которые на больших расстояниях превращаются в плоские волны  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ . Их разложение по сферическим волнам имеет следующий вид (см. § 136 в [20]):

$$\begin{aligned} \psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r}) &= \\ &= \frac{2\pi}{k} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l e^{i\delta_l} R_{kl}(r) Y_{l,m}^* \left( \frac{\mathbf{k}}{k} \right) Y_{l,m} \left( \frac{\mathbf{r}}{r} \right), \end{aligned} \quad (6)$$

где фаза

$$\delta_l = \arg \Gamma[l + 1 - (i/ka_B)],$$

а радиальная функция  $R_{kl}(r)$  имеет размерность обратной длины и при выборе нормировки согласно § 136 в [20] равна

$$R_{kl}(r) = \frac{C_{kl}}{(2l+1)!} (2kr)^l e^{-ikr} \times F\left(l+1 + \frac{i}{ka_B}, 2l+2, 2ikr\right). \quad (7)$$

Здесь  $F(\alpha, \beta, z)$  — вырожденная гипергеометрическая функция, введен борковский радиус экситона  $a_B = \kappa \hbar^2 / e^2 \mu$ ,  $\kappa$  — диэлектрическая проницаемость среды. Приведем выражения для коэффициентов  $C_{kl}$  для орбитального момента  $l = 0$  и 1:

$$C_{k0} = 2k\sqrt{Z}, \quad C_{k1} = \sqrt{1 + \frac{1}{(ka_B)^2}} C_{k0}, \quad (8)$$

где фактор Зоммерфельда равен

$$Z = \frac{X}{1 - \exp(-X)}, \quad X = \frac{2\pi}{ka_B}. \quad (9)$$

В литературе встречаются и другие нормировки:

$$R_{kl}^{LL}(r) = \sqrt{2\pi} R_{kl}^G(r) = \sqrt{2\pi} k R_{kl}^{VP}(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi k}} R_{kl}^K(r) = 2k R_{kl}^{Ell}(r), \quad (10)$$

где функция  $R_{kl}(r)$  в нормировке Ландау и Лифшица, входящая в формулу (6), обозначена для ясности в виде  $R_{kl}^{LL}(r)$ , а остальные функции с верхними индексами  $G, VP, K$  и  $Ell$  введены в статьях [30–33] соответственно. При использовании в разложении (6) радиальных функций с другой нормировкой нужно умножить это разложение на соответствующий коэффициент в соотношениях (10). Энергия возбуждения электрон-дырочного состояния (6) имеет параболическую дисперсию

$$E_{\mathbf{k}} = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}. \quad (11)$$

В дальнейшем будет использовано также разложение кулоновской волновой функции по состояниям невзаимодействующих электрона и дырки,

$$|s_e, s_h, \mathbf{k}\rangle = \Psi_{s_e, s_h, \mathbf{k}}^{(+)} = \sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} |s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free}\rangle, \quad (12)$$

где

$$|s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free}\rangle = e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} u_{\Gamma_6, s_e}(\mathbf{r}_e) u_{\Gamma_7, s_h}^{(h)}(\mathbf{r}_h),$$

$C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})}$  — фурье-образ огибающей  $\psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r})$ .

### 3. ДВА ВКЛАДА В ЛИНЕЙНЫЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК

В фотоиндуцированный электрический ток вносят вклады эффект увлечения электронов фотонами, циркулярный и линейный фотогальванические эффекты (ФГЭ). Первый вклад возникает за счет передачи импульса фотонов свободным носителям заряда, он пропорционален волновому вектору света. Второй вклад обусловлен преобразованием углового момента циркулярно поляризованных фотонов в поступательное движение свободных электронов или дырок и пропорционален степени циркулярной поляризации излучения  $P_{circ}$ . Линейный ФГЭ возникает в пьезоэлектриках, он не зависит от волнового вектора света или степени поляризации  $P_{circ}$  и изучается обычно при линейной поляризации возбуждающего света.

В свою очередь линейный фототок состоит из баллистического и сдвигового вкладов:

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}^{(bal)} + \mathbf{j}^{(sh)}.$$

Без учета кулоновского взаимодействия эти токи вычисляются в одночастичном приближении по формулам

$$\begin{aligned} \mathbf{j}^{(bal)} &= e \sum_l \sum_{\mathbf{k} s' s} \mathbf{v}_{l s, l s'}(\mathbf{k}) \bar{\rho}_{l s', l s}(\mathbf{k}), \\ \mathbf{j}^{(sh)} &= e \sum_{l \neq l'} \sum_{\mathbf{k} s' s} \mathbf{v}_{l s, l' s'}(\mathbf{k}) \bar{\rho}_{l' s', l s}(\mathbf{k}), \end{aligned} \quad (13)$$

где  $l', l$  — индексы зон  $c$  и  $v$ ,  $s, s'$  — спиновые индексы,  $\mathbf{v}_{l s, l' s'}$  — матричные элементы оператора скорости,  $\bar{\rho}_{l' s', l s}(\mathbf{k})$  — одночастичная матрица плотности, черта означает усреднение по времени. С учетом кулоновского взаимодействия формулы (13) принимают вид

$$\mathbf{j}^{(bal)} = e \sum_{\mathbf{k} \mathbf{k}' s_e s_h} \mathbf{v}_{\mathbf{k}' \mathbf{k}} \bar{\rho}_{s_e, s_h, \mathbf{k}; s_e, s_h, \mathbf{k}'} + \text{c.c.}, \quad (14a)$$

$$\mathbf{j}^{(sh)} = e \sum_{\mathbf{k} s_e s_h} \langle 0 | \hat{\mathbf{v}} | s_e, s_h, \mathbf{k} \rangle \overline{\rho_{s_e, s_h, \mathbf{k}; 0}} + \text{c.c.}, \quad (14b)$$

где

$$\mathbf{v}_{\mathbf{k}' \mathbf{k}} = \int \psi_{\mathbf{k}'}^{(+)*}(\mathbf{r}) \left( -i \frac{\hbar}{\mu} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right) \psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (15)$$

$|0\rangle$  — основное состояние кристалла (валентная зона заполнена, зона проводимости пустая). Краткий вывод формул (14a), (15) приведен в Приложении А. Там же приводится и выражение для матричного элемента оператора  $\hat{\mathbf{v}}$  в (14b) через коэффициенты  $C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})}$ .

В объемном полупроводнике симметрии  $T_d$  линейный фотогальванический эффект, как баллистический, так и сдвиговой, описывается феноменологическим уравнением [34]

$$j_i = \chi e_{i+1} e_{i+2} \mathcal{E}_0^2. \quad (16)$$

Здесь  $\mathcal{E}_0$  — вещественная амплитуда электрического поля излучения,  $e$  — единичный вектор линейной поляризации,  $i = x, y, z$ , и предполагается циклическая перестановка координат  $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ . Для определенности мы рассмотрим поляризацию

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad (17)$$

при которой индуцируется фототок в  $z$ -направлении. В пренебрежении волновым вектором фотона векторный потенциал и электрическое поле осциллируют во времени согласно

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(t) &= eA_0 (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}), \\ \mathcal{E}(t) &= 2e\mathcal{E}_0 \sin \omega t, \quad A_0 = \frac{c}{\omega} \mathcal{E}_0. \end{aligned} \quad (18)$$

При этом оператор взаимодействия света с электронами принимает вид

$$\hat{V}(t) = \hat{V}(e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}),$$

где

$$\hat{V} = -\frac{e}{\omega} (\hat{v}_0 \cdot e) \mathcal{E}_0, \quad \hat{v}_0 = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial H_0}{\partial \mathbf{k}}. \quad (19)$$

### 3.1. Матричные элементы оптического возбуждения

В отсутствие кулоновского взаимодействия при условии (3) и в поляризации (17) для матричных элементов оптических переходов в электронном представлении имеем

$$\begin{aligned} V_{c, \pm \frac{1}{2}, \mathbf{k}; v, \pm \frac{1}{2}, \mathbf{k}} &= \mp i \frac{e\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}\hbar\omega} Q(k_x + k_y), \\ V_{c, \pm \frac{1}{2}, \mathbf{k}; v, \mp \frac{1}{2}, \mathbf{k}} &= -\frac{1 \mp i}{\sqrt{2}} \frac{e\mathcal{E}_0}{\hbar\omega} (P + iQk_z). \end{aligned} \quad (20)$$

К фототоку приводят только переходы

$$(v, -1/2, \mathbf{k}) \rightarrow (c, 1/2, \mathbf{k})$$

и

$$(v, 1/2, \mathbf{k}) \rightarrow (c, -1/2, \mathbf{k}),$$

в матричных элементах которых содержатся оба коэффициента  $P$  и  $Q$ . Заметим, что при выводе формул (20) мы учли условие (3), при котором

$\mathbf{k}p$ -смешиванием состояний зоны проводимости и валентной зоны можно пренебречь, одночастичные начальные и конечные состояния имеют вид

$$\begin{aligned} \psi_{c,s,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} u_{\Gamma_6,s}(\mathbf{r}), \\ \psi_{v,s,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} u_{\Gamma_7,s}(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (21)$$

и матричные элементы (20) не содержат слагаемых второго или более высокого порядка по  $\mathbf{k}$ .

Используя теорию Эллиота [33], мы можем обобщить уравнение (20) для переходов из основного состояния  $|0\rangle$  в электрон-дырочное кулоновское состояние  $|s_e = \pm 1/2, s_h = \pm 1/2, \mathbf{k}\rangle$ :

$$\begin{aligned} \langle \pm 1/2, \pm 1/2, \mathbf{k} | \hat{V} | 0 \rangle &\equiv V_{\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \mathbf{k}; 0} = \\ &= -\frac{1 \mp i}{\sqrt{2}} \frac{e\mathcal{E}_0}{\hbar\omega} (e^{-i\delta_0} P + i e^{-i\delta_1} Q S k_z) \sqrt{\mathcal{Z}}, \end{aligned} \quad (22)$$

где

$$S = \sqrt{1 + \frac{1}{(ka_B)^2}},$$

и фактор Зоммерфельда определен согласно (9). При больших значениях  $ka_B$  факторы  $\mathcal{Z}$  и  $S$  стремятся к единице, а фазы  $\delta_0, \delta_1$  — к нулю, и формула (22) переходит в формулу (20) (с учетом различных знаков у проекции спина в дырочном и электронном представлениях).

Из (22) следует, что основной вклад в вероятность поглощения света в единицу времени в единицу объема равна

$$W = \frac{4\pi}{\hbar} \left( \frac{eP}{\hbar\omega} \right)^2 g(\hbar\omega) \mathcal{Z} \mathcal{E}_0^2, \quad (23)$$

где приведенная плотность состояний дается формулой

$$\begin{aligned} g(\hbar\omega) &= \sum_{\mathbf{k}} \delta(\hbar\omega - E_{\mathbf{k}}) = \frac{\mu k(\omega)}{2\pi^2 \hbar^2}, \\ k(\omega) &= \sqrt{\frac{2\mu(\hbar\omega - E_g)}{\hbar^2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

## 4. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ФОТОТОК

Для расчета баллистического тока нужно найти матрицу плотности  $\bar{\rho}_{s_e, s_h, \mathbf{k}; s_e, s_h, \mathbf{k}'}$  и матричный элемент оператора скорости  $\mathbf{v}_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}$ . Сделаем это последовательно.

### 4.1. Двухчастичная матрица плотности

Обозначим для краткости основное состояние кристалла  $|0\rangle$  и возбужденные состояния  $|s_e, s_h, \mathbf{k}\rangle$

одним индексом  $n, n'$  или  $m$ . Матрица плотности  $\rho_{nn'}(t) = \rho_{n'n}^*(t)$  удовлетворяет системе уравнений

$$\begin{aligned} \left[ \varepsilon_{n'} - \varepsilon_n + i\hbar(\gamma_n + \gamma_{n'}) + i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right] \rho_{nn'}(t) = \\ = \sum_m [V_{nm}(t)\rho_{mn'}(t) - \rho_{nm}(t)V_{mn'}(t)], \end{aligned} \quad (25)$$

где  $\varepsilon_n$  — энергия электронной системы в состоянии  $n$ ,  $V_{mn}(t)$  — матричный элемент оператора взаимодействия с электромагнитным полем. Для основного состояния  $|0\rangle$  затухание  $\gamma_0 = 0$ , для возбужденных состояний параметр  $\gamma_n \equiv \gamma$  учитывает рассеяние электрон-дырочной пары на примесях или фононах. Для линейно поляризованного света (18) имеем

$$V_{mn}(t) = V_{mn} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}).$$

В собственном полупроводнике при низкой температуре исходная матрица плотности имеет одну ненулевую компоненту

$$\rho_{nn'}^{(0)} = \delta_{n0}\delta_{n'0}. \quad (26)$$

В первом порядке по теории возмущений временная зависимость матрицы плотности имеет вид

$$\rho_{n0}^{(1)}(t) = \rho_{0n}^{(1)*}(t) = \rho_{n0}^{(+1)} e^{-i\omega t} + \rho_{n0}^{(-1)} e^{i\omega t}, \quad (27)$$

где  $n$  — любое возбужденное состояние. Подставляя в левую часть уравнения (25) это выражение для матрицы плотности, а в правую часть — выражение (26), находим

$$\begin{aligned} \rho_{n0}^{(+1)} &= \frac{V_{n0}}{\hbar\omega - E_n + i\hbar\gamma}, \\ \rho_{0n}^{(-1)} &= \frac{V_{0n}}{\hbar\omega - E_n - i\hbar\gamma}, \end{aligned} \quad (28)$$

где учтено, что разность  $\varepsilon_n - \varepsilon_0$  есть энергия возбуждения  $E_n$ , определенная согласно (11). Нерезонансные компоненты  $\rho_{n0}^{(-1)}$  и  $\rho_{0n}^{(+1)}$  не выписаны, так как они не вносят вклада в баллистический фототок.

Для второго порядка теории возмущений после усреднения по времени для компонент матрицы плотности с  $n, n' \neq 0$  получаем

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_{nn'}^{(2)} &= \frac{V_{n0}V_{0n'}}{E_{n'} - E_n + 2i\hbar\gamma} \times \\ &\times \left( \frac{1}{\hbar\omega - E_{n'} - i\hbar\gamma} - \frac{1}{\hbar\omega - E_n + i\hbar\gamma} \right). \end{aligned} \quad (29)$$

Заменив  $n$  на  $s_e, s_h, \mathbf{k}$  и  $n'$  на  $s_e, s_h, \mathbf{k}'$ , а энергетические знаменатели на дельта-функции, окончательно находим

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_{s_e, s_h, \mathbf{k}; s_e, s_h, \mathbf{k}'}^{(2)} &= i\pi \frac{V_{s_e, s_h, \mathbf{k}; 0} V_{0; s_e, s_h, \mathbf{k}'}}{E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}} + 2i\hbar\gamma} \times \\ &\times [\delta(\hbar\omega - E_{\mathbf{k}'}) + \delta(\hbar\omega - E_{\mathbf{k}})]. \end{aligned} \quad (30)$$

Вклад в фототок вносит нечетная составляющая произведения

$$\begin{aligned} \left( V_{\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \mathbf{k}; 0} V_{0; \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \mathbf{k}'} \right)_{\text{odd}} &= i \left( \frac{e\mathcal{E}_0}{\hbar\omega} \right)^2 \times \\ &\times PQ \left( e^{i(\delta'_0 - \delta_1)} \mathcal{S}k_z - e^{-i(\delta_0 - \delta'_1)} \mathcal{S}'k'_z \right) \sqrt{\mathcal{Z}\mathcal{Z}'}, \end{aligned} \quad (31)$$

где

$$\delta'_l = \delta_l(k'), \quad \mathcal{Z}' = \mathcal{Z}(k'), \quad \mathcal{S}' = \mathcal{S}(k').$$

Отсюда следует, что суммирование по спинам в (14а) можно заменить удвоением выражения (31).

#### 4.2. Матричный элемент оператора скорости

С учетом связи между матричными элементами скорости и координаты интеграл (15) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \int \psi_{\mathbf{k}'}^{(+)*}(\mathbf{r}) \left( -i \frac{\hbar}{\mu} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right) \psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \\ = i \frac{E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}}}{\hbar} \int \psi_{\mathbf{k}'}^{(+)*}(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \end{aligned} \quad (32)$$

Далее нужно подставить разложения (6) функций  $\psi_{\mathbf{k}}^{(+)}$  и  $\psi_{\mathbf{k}'}^{(+)}$  в правый интеграл и учесть, что после интегрирования останутся только вклады с  $l - l' = \pm 1$ . Согласно (31), угловая зависимость матрицы плотности (30) обусловлена множителями  $k_z$  и  $k'_z$ . Поэтому в интегралах (32) нужно оставить только слагаемые с  $l = 0, l' = 1, m' = 0$  и  $l = 1, m = 0, l' = 0$ . В результате для этой части матричного элемента координаты  $z$  получим

$$\begin{aligned} z_{\mathbf{k}'\mathbf{k}} \rightarrow i \frac{\pi}{kk'} \times \left( \frac{k_z}{k} e^{-i(\delta'_0 - \delta_1)} \mathcal{S}I_{k1, k'0} - \right. \\ \left. - \frac{k'_z}{k'} e^{i(\delta_0 - \delta'_1)} \mathcal{S}'I_{k0, k'1} \right), \end{aligned} \quad (33)$$

где

$$I_{kl, k'l'} = \int_0^\infty r^3 dr R_{kl}(r) R_{k'l'}(r). \quad (34)$$

Найдем среднее по направлениям векторов  $\mathbf{k}$  и  $\mathbf{k}'$  от произведения (31) и (33):

$$\begin{aligned} \int \frac{d\Omega_{\mathbf{k}} d\Omega_{\mathbf{k}'}}{(4\pi)^2} z_{\mathbf{k}'\mathbf{k}} \left( V_{\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \mathbf{k}; 0} V_{0; \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \mathbf{k}'} \right)_{\text{odd}} = \\ = -\frac{\pi}{3} \left( \frac{e\mathcal{E}_0}{\hbar\omega} \right)^2 PQ \sqrt{\mathcal{Z}\mathcal{Z}'} \left( \frac{\mathcal{S}I_{k1, k'0}}{k'} + \frac{\mathcal{S}'I_{k0, k'1}}{k} \right). \end{aligned} \quad (35)$$

Отсюда следует, что после такого усреднения фазы  $\delta_l$  в выражениях (31) и (33) взаимно уничтожаются и при дальнейшем расчете тока (14а) не возникнут.



### 4.3. Расчет баллистического фототока

Преобразуем энергетический знаменатель в выражении (29) следующим образом:

$$\frac{1}{E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}} + 2i\hbar\gamma} = \frac{E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}} - 2i\hbar\gamma}{(E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}})^2 + (2\hbar\gamma)^2}. \quad (36)$$

Поскольку интеграл (35) является действительным, мнимая часть выражения (36) не вносит вклада в ток, и это выражение можно заменить на

$$\frac{E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}}}{(E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}})^2 + (\hbar/\tau)^2},$$

где  $\tau = (2\gamma)^{-1}$  — время рассеяния. Сумма (14а) для тока  $j_z$ , усредненная по углам волновых векторов, принимает вид

$$j_z^{(bal)} = \frac{\pi e}{\hbar} \left( \frac{eE}{\hbar\omega} \right)^2 2PQ \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \frac{(E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}})^2}{(E_{\mathbf{k}'} - E_{\mathbf{k}})^2 + (\hbar/\tau)^2} \times \\ \times \frac{\pi}{3} \left( \frac{SI_{k1,k'0}}{k'} + \frac{S'I_{k0,k'1}}{k} \right) \times \\ \times \sqrt{ZZ'} [\delta(\hbar\omega - E_{\mathbf{k}}) + \delta(\hbar\omega - E_{\mathbf{k}'})]. \quad (37)$$

Таким образом, для нахождения баллистического фототока требуется рассчитать интегралы  $I_{k1,k'0}$ ,  $I_{k0,k'1}$ . Этот расчет вынесен в Приложение В. С учетом уравнений (23), (60), (61), (64) вместо (37) получаем

$$j_z^{(bal)} = eW \frac{Q}{P} \frac{2\pi}{3} \frac{\pi\tau}{\hbar} \left( \frac{\hbar^2}{2\mu} \right)^2 4k^2 \frac{\mu k}{2\pi^2 \hbar^2} \frac{2\pi}{k} \frac{1}{\pi} \frac{1}{ka_B} = \\ = e \frac{Q}{P} W \frac{2}{3} \frac{\tau}{\hbar} \frac{\hbar^2 k}{\mu a_B}. \quad (38)$$

Это главный результат работы.

### 4.4. Другой способ расчета баллистического тока

В этом разделе мы проигнорируем влияние кулоновского взаимодействия на матричный элемент оператора скорости и учтем это взаимодействие только в матричном элементе оптического возбуждения (22). При таком подходе выражение для фототока принимает вид

$$j_z = \frac{2\pi}{\hbar} e\tau \sum_{s_e, s_h, \mathbf{k}} \frac{\hbar k_z}{\mu} |V_{s_e, s_h, \mathbf{k}; 0}|^2 \delta(E_{\mathbf{k}} - \hbar\omega). \quad (39)$$

Подставляя выражения (22) в эту формулу и усредняя по направлению вектора  $\mathbf{k}$ , получаем

$$j_z = \frac{2\pi}{\hbar} 2PQ e\tau \sum_{\mathbf{k}} \frac{\hbar k^2}{3\mu} 2 \sin(\delta_1 - \delta_0) ZS \delta(E_{\mathbf{k}} - \hbar\omega) = \\ = \frac{2}{3} \frac{Q}{P} W \tau S \frac{\hbar k^2}{\mu} \sin(\delta_1 - \delta_0). \quad (40)$$

Учитывая далее, что

$$\sin(\delta_1 - \delta_0) = \frac{1}{ka_B S},$$

приходим к той же формуле (38). Таким образом, оба подхода дают одинаковый результат.

## 5. СДВИГОВЫЙ ФОТОТОК

Для вывода выражения для сдвигового тока в многозонной модели [4] требуется подставить в (14b) второй порядок матрицы плотности  $\bar{\rho}_{s_e, s_h, \mathbf{k}; 0}^{(2)}$ . Важно, что в двухзонной модели (2) с нелинейными по  $\mathbf{k}$  недиагональными слагаемыми оператор скорости содержит линейный по электрическому полю вклад

$$\hat{v} = \hat{v}_0 + \delta\hat{v}(e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}). \quad (41)$$

Поэтому выражение для сдвигового тока содержит дополнительный вклад от матрицы плотности первого порядка и имеет вид

$$\mathbf{j}^{(sh)} = e \sum_n \left( \langle 0 | \hat{v}_0 | n \rangle \bar{\rho}_{n;0}^{(2)} + \langle 0 | \delta\hat{v} | n \rangle \rho_{n;0}^{(+1)} \right) + \text{c.c.} \quad (42)$$

Начнем преобразование этой суммы со второго слагаемого. Матрица плотности первого порядка  $\bar{\rho}_{n;0}^{(+1)}$  определена согласно (28). Разложим множитель  $\langle 0 | \delta\hat{v} | n \rangle$  по матричным элементам для состояний свободных электрон-дырочных пар:

$$\langle 0 | \delta\hat{v} | s_e, s_h, \mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} \langle 0 | \delta\hat{v} | s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free} \rangle. \quad (43)$$

Тождество

$$\delta v = \frac{i}{\hbar} [\hat{V}, \mathbf{r}]$$

позволяет переписать матричный элемент в сумме (43) в виде

$$\langle 0 | \delta\hat{v} | s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free} \rangle = \langle c, s_e, \mathbf{q} | \delta\hat{v} | v, -s_h, \mathbf{q} \rangle = \\ = \frac{i}{\hbar} \sum_{l, s, \mathbf{q}'} \left( V_{c, s_e, \mathbf{q}; l, s, \mathbf{q}'} T_{l, s, \mathbf{q}'; v, -s_h, \mathbf{q}} - \right. \\ \left. - r_{c, s_e, \mathbf{q}; l, s, \mathbf{q}'} V_{l, s, \mathbf{q}'; -s_h, \mathbf{q}} \right). \quad (44)$$

Матричные элементы координаты рассчитываются по формулам [4]

$$\begin{aligned} r_{l,sq;l,s',q'} &= i\delta_{s's} \frac{\partial \delta_{q',q}}{\partial \mathbf{q}} \quad (l = c, v), \\ r_{c,sq;v,s',q'} &= -\delta_{q',q} i\hbar \frac{v_{c,s,q;v,s',q}}{\varepsilon_{c,q} - \varepsilon_{v,q}}. \end{aligned} \quad (45)$$

Подставляя эти формулы в сумму (44), получим

$$\begin{aligned} \langle 0 | \delta \hat{v} | s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free} \rangle &= \frac{1}{\hbar} \left[ \frac{\partial V_{c,s_e,q;v,-s_h,q}}{\partial \mathbf{q}} + \right. \\ &\left. + \frac{\hbar v_{c,s_e,q;v,-s_h,q}}{\varepsilon_{c,q} - \varepsilon_{v,q}} (V_{c,q;c,q} - V_{v,q;v,q}) \right]^*, \end{aligned} \quad (46)$$

где

$$V_{c,q;c,q} - V_{v,q;v,q} = -\frac{\hbar(qe)}{\mu} \frac{e\mathcal{E}_0}{\omega}.$$

При замене базисных функций (21)

$$\psi_{c,s,\mathbf{k}} \rightarrow e^{i\varphi(c,s,\mathbf{k})} \psi_{c,s,\mathbf{k}}, \quad \psi_{v,s,\mathbf{k}} \rightarrow e^{i\varphi(v,s,\mathbf{k})} \psi_{v,s,\mathbf{k}},$$

где  $\varphi(l, s, \mathbf{k})$  — гладкая функция  $\mathbf{k}$ , в квадратных скобках уравнения (46) появится дополнительное слагаемое

$$\begin{aligned} &[\Omega_{c,s_e}(\mathbf{q}) - \Omega_{v,-s_h}(\mathbf{q})] V_{c,s_e,q;v,-s_h,q} = \\ &= i \left( \frac{\partial \varphi(c, s_e, \mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\partial \varphi(v, -s_h, \mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} \right) V_{c,s_e,q;v,-s_h,q}, \end{aligned}$$

так что матричный элемент (46) останется инвариантным к такой замене.

Решая уравнение (25) во втором порядке, находим

$$\begin{aligned} \langle n | \bar{\rho}^{(2)} | 0 \rangle &= -\frac{\langle n | [\hat{V}, \hat{\rho}^{(1)}] | 0 \rangle}{E_n} = \\ &= -\frac{1}{E_n} \sum_m V_{nm} \bar{\rho}_{m0}^{(+1)}. \end{aligned} \quad (47)$$

Представим ток (42) в виде суммы

$$\mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2 + \mathbf{j}_3,$$

где  $\mathbf{j}_1$  — вклад, связанный с  $\bar{\rho}_{n;0}^{(2)}$ , а  $\mathbf{j}_2, \mathbf{j}_3$  — вклады, связанные с  $\bar{\rho}_{n;0}^{(1)}$  и определяемые первым и вторым слагаемыми в квадратных скобках (46). Можно проверить, что в пренебрежении кулоновским взаимодействием токи  $\mathbf{j}_1$  и  $\mathbf{j}_3$  сокращаются. Поэтому

при учете электрон-дырочного взаимодействия сумма  $\mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_3$  имеет малость порядка  $E_B/E_g$  по сравнению с током  $\mathbf{j}_2$  и сохранение этой суммы есть превышение точности, так как при расчете модифицированных электрон-дырочных состояний мы пренебрегаем слагаемыми, имеющими такую малость. Учет этих поправок при расчете экситонных состояний и силы осциллятора экситона проводился в работе [40] и здесь не приводится.

Таким образом, сдвиговой фототок с учетом кулоновского взаимодействия определяется выражением

$$\mathbf{j}^{(sh)} = e \frac{2\pi}{\hbar} \sum_n \mathbf{R}_n |V_n|^2 \delta(E_n - \hbar\omega), \quad (48)$$

где  $V_n = \langle s_e, s_h, \mathbf{k} | V | 0 \rangle$ ,  $\mathbf{R}_n$  — элементарный сдвиг заряда при оптическом переходе

$$\mathbf{R}_n = -\frac{1}{|V_n|^2} \text{Im} \left( V_n^* \sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})*} \frac{\partial V_{c,s_e,q;v,-s_h,q}}{\partial \mathbf{q}} \right). \quad (49)$$

Подставим в (48) выражения для матричных элементов (20) и (22). Поскольку производная матричного элемента (20) не зависит от  $\mathbf{q}$ , мы можем переписать сумму по  $\mathbf{q}$  в виде

$$\sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})*} \frac{\partial V_{c,s_e,q;v,-s_h,q}}{\partial \mathbf{q}} = \sqrt{Z} \frac{\partial V_{c,s_e,\mathbf{k};v,-s_h,\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{k}}.$$

В итоге получаем второй важный результат работы:

$$\mathbf{j}^{(sh)}(\text{Coul}) = -e \frac{Q}{P} W = Z \mathbf{j}^{(sh)}(\text{no-Coul}). \quad (50)$$

Как видим, в рассматриваемой двухзонной модели отношение сдвиговых фототоков, рассчитанных с учетом и без учета кулоновского взаимодействия, совпадает с аналогичным отношением коэффициентов поглощения света.

## 6. СРАВНЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО И СДВИГОВОГО ВКЛАДОВ

Из формулы (38) следует частотная зависимость баллистического фототока

$$j_z^{(bal)} = \frac{C}{a_B^2} \frac{k(\omega)}{1 - \exp[-2\pi/k(\omega)a_B]}, \quad (51)$$

где волновой вектор  $k(\omega)$  определен в (24) и коэффициент  $C$  не зависит от эффективной массы  $\mu$  и частоты  $\omega$ . Такую же частотную зависимость имеет выражение для тока, приведенное в работе [25]. Однако в эту формулу при совпадающих эффективных массах электрона и дырки масса  $\mu$  входит только в показатель экспоненты, тогда как выражение (51) содержит еще множитель  $\mu^2$  (из-за наличия  $a_B^2$  в знаменателе).

Согласно (38) и (50) отношение кулоновского баллистического и сдвигового вкладов в ток описывается уравнением

$$\frac{|j_z^{(bal)}|}{|j_z^{(sh)}|} = \frac{2\tau}{3\hbar} \frac{\hbar^2 k}{\mu a_B} = \frac{4\tau}{3\hbar} \sqrt{E_B(\hbar\omega - E_g)} = \frac{2}{3} \frac{\ell}{a_B}, \quad (52)$$

где  $\ell$  — длина свободного пробега  $\tau\hbar k/\mu$ . Таким образом, мы подтверждаем утверждение, сделанное в статье [7]: за исключением особых случаев экстремально большого значения экситонного боровского радиуса (малая эффективная масса, большая диэлектрическая проницаемость) и очень короткого времени рассеяния, баллистический ток преобладает над сдвиговым. Согласно (52), условием этого преобладания является неравенство  $\ell \gg a_B$ , а не неравенство  $\ell \gg a$ , указанное в [7] ( $a$  — постоянная решетки). Подчеркнем, что, в отличие от межзонного поглощения, при межподзонных переходах в одной зоне сдвиговый и фононный баллистический механизмы вносят определяющие и сопоставимые вклады в ЛФГЭ [36–38].

Противоположное утверждение о преобладании сдвигового вклада над баллистическим сделано в работах [8, 9]. Возможно, это связано с тем, что во втором слагаемом в уравнении (8) в [8] или уравнении (22) в [9] включена в качестве множителя лишняя мнимая единица.

## 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках одной модели зонной структуры объемного полупроводника выведены выражения для баллистического и сдвигового вкладов в линейный фотогальванический эффект, соответственно  $j^{(bal)}$  и  $j^{(sh)}$ . Оба вклада рассчитаны с учетом кулоновского электрон-дырочного взаимодействия. Показано, что при межзонных переходах в типичных полупроводниках баллистический вклад существенно пре-

вышает сдвиговый вклад. Оценка для отношения  $j^{(bal)}/j^{(sh)}$  составляет  $(\tau/\hbar)[E_B(\hbar\omega - E_g)]^{1/2}$ . В рассматриваемой двухзонной модели отношение сдвигового тока  $j^{(sh)}$  к коэффициенту поглощения света не зависит от частоты, тогда как для баллистического фототока это отношение с увеличением частоты монотонно растет по корневому закону  $\sqrt{\hbar\omega - E_g}$  (при неизменном времени релаксации  $\tau$ ). Мы рассмотрели относительно простую двухзонную модель, которая позволила вывести аналитические формулы (38) и (50). Использование более сложной модели потребует численного расчета кулоновских электрон-дырочных функций.

В последние годы появилось много публикаций, см. Введение, а также работу [40], в которых достигнуты успехи по численному расчету сдвигового ЛФГЭ при межзонных переходах. Дополнительный расчет баллистического фототока с учетом кулоновского электрон-дырочного взаимодействия позволит получить значительно большие значения суммарного фототока.

**Благодарности.** Мы признательны Л. Е. Голубу, Б. И. Стурману, С. А. Тарасенко и М. В. Энтину за полезные обсуждения.

**Финансирование.** Финансовая поддержка работы оказана Российским научным фондом в рамках проекта № 22-12-00211.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ЭЛЕКТРОН-ДЫРОЧНОЙ КУЛОНОВСКОЙ ПАРЫ

Пара свободных электрона и дырки, двигающихся навстречу друг другу со скоростями  $\hbar\mathbf{q}/m^*$  и  $-\hbar\mathbf{q}/m^*$ , переносит ток

$$\mathbf{j} = e \left[ \frac{\hbar\mathbf{q}}{m^*} - \left( -\frac{\hbar\mathbf{q}}{m^*} \right) \right] = e \frac{\hbar\mathbf{q}}{\mu}.$$

На языке квантовой физики это означает, что матричный элемент оператора тока между состояниями свободных пар равен

$$\langle s'_e, \mathbf{q}' ; s'_h, -\mathbf{q}' ; \text{free} | \hat{\mathbf{j}} | s_e, \mathbf{q} ; s_h, -\mathbf{q} ; \text{free} \rangle = e \frac{\hbar\mathbf{q}}{\mu} \delta_{\mathbf{q}\mathbf{q}'} \delta_{s_e s'_e} \delta_{s_h s'_h}. \quad (53)$$

Используя разложение (12) кулоновской волновой функции по состояниям невзаимодействующих



электрона и дырки, вычислим матричный элемент между двумя кулоновскими состояниями:

$$\begin{aligned} \langle s'_e, s'_h, \mathbf{k}' | \hat{j} | s_e, s_h, \mathbf{k} \rangle &= \sum_{\mathbf{q}\mathbf{q}'} C_{\mathbf{q}'}^{(\mathbf{k}')*} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} \times \\ &\times \langle s'_e, \mathbf{q}'; s'_h, -\mathbf{q}'; \text{free} | \hat{j} | s_e, \mathbf{q}; s_h, -\mathbf{q}; \text{free} \rangle = \\ &= e \delta_{s_e s'_e} \delta_{s_h s'_h} \sum_{\mathbf{q}\mathbf{q}'} C_{\mathbf{q}'}^{(\mathbf{k}')*} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} \frac{\hbar \mathbf{q}}{\mu} \delta_{\mathbf{q}\mathbf{q}'} = \\ &= e \delta_{s_e s'_e} \delta_{s_h s'_h} \sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k}')*} \frac{\hbar \mathbf{q}}{\mu} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} = \\ &= e \delta_{s_e s'_e} \delta_{s_h s'_h} \int \psi_{\mathbf{k}'}^{(+)*}(\mathbf{r}) \left( -i \frac{\hbar}{\mu} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right) \psi_{\mathbf{k}}^{(+)}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \end{aligned} \quad (54)$$

Умножая этот матричный элемент на матрицу плотности и суммируя по волновым векторам и спиновым состояниям, получаем (14а), (15).

Матричный элемент  $\langle 0 | \hat{v} | s_e, s_h, \mathbf{k} \rangle$  в формуле (14b) выражается через фурье-компоненты  $C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})}$  в виде

$$\langle 0 | \hat{v} | s_e, s_h, \mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{k})} \mathbf{v}_{c, s_e; v, -s_h}^*(\mathbf{q}), \quad (55)$$

где одночастичное электронное состояние  $|v, -s_h, \mathbf{q}\rangle$  отличается от дырочного состояния  $|h, s_h, -\mathbf{q}\rangle$  операцией инверсии времени.

### ПРИЛОЖЕНИЕ В.

#### МАТРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КООРДИНАТЫ МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ КОНТИНУУМА

Здесь мы рассчитаем интеграл (34). Вначале заметим, что для радиальных функций свободного движения,

$$R_{k_0}^{(0)}(r) = 2 \frac{\sin kr}{r}, \quad R_{k_1}^{(0)}(r) = 2 \left( \frac{\sin kr}{kr^2} - \frac{\cos kr}{r} \right)$$

матричные элементы координаты  $r$  имеют сингулярный вид:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty R_{k_1}^0(r) R_{k'_0}^0(r) r^3 dr &= \\ &= 2\pi \left[ \frac{\partial}{\partial k'} \delta(k' - k) + \frac{1}{k} \delta(k' - k) \right], \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty R_{k_0}^0(r) R_{k'_1}^0(r) r^3 dr &= \\ &= 2\pi \left[ -\frac{\partial}{\partial k'} \delta(k' - k) + \frac{1}{k} \delta(k' - k) \right]. \end{aligned} \quad (57)$$

Подстановка этих выражений в (37) вместо интегралов (34) не приводит к фототоку в силу тождеств

$$(x' - x)^2 \frac{\partial \delta(x' - x)}{\partial x'} = 0, \quad (x' - x)^2 \delta(x' - x) = 0.$$

Это согласуется с утверждением, что без учета кулоновского взаимодействия линейный баллистический ток при прямых межзонных переходах не возникает.

Для кулоновских функций  $R_{kl}(r)$  интеграл (34) приводится к виду [31, 32, 39]

$$I_{k_1, k'_0} = A \frac{\partial}{\partial k'} \delta(k' - k) + B \delta(k' - k) + 2\pi I_{k_1, k'_0}^G, \quad (58)$$

где  $A, B$  — функции  $k$ , в частности,

$$A = 2\pi [1 + (ka_B)^{-2}]^{-1/2},$$

см., например, формулу (3.7) в работе [31], а интеграл  $I_{k_1, k'_0}^G$  был рассчитан Гордоном в 1929 г. [30]. В третьем слагаемом вошел множитель  $2\pi$ , так как в подынтегральную функцию (34) входят радиальные функции в нормировке Ландау — Лифшица, отличающиеся в  $\sqrt{2\pi}$  раз от радиальных функций в [30], см. (10). Как и в случае свободных пар, два первых слагаемых вклада в фототок не вносят. Поэтому баллистический фототок определяется интегралом Гордона, который мы представим в следующем виде:

$$I_{k_1, k'_0}^G = \frac{f(k, k')}{(k' - k)^2}. \quad (59)$$

Здесь

$$f(k, k') = i \frac{2kk'}{(k + k')^2} e^{\frac{\pi}{2a_B} \left| \frac{1}{k'} - \frac{1}{k} \right|} \times$$

$$\begin{aligned} &\times \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{(ka_B)^2}}{ka_B \operatorname{sh} \frac{\pi}{ka_B} k' a_B \operatorname{sh} \frac{\pi}{k' a_B}}} \times \\ &\times \left\{ \left| \frac{k - k'}{k + k'} \right|^{-\frac{i}{a_B} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k'} \right)} \times \right. \\ &\times {}_2F_1 \left( -\frac{i}{ka_B}, 1 + \frac{i}{k' a_B}, 2, \frac{4kk'}{(k + k')^2} \right) \\ &\left. - \left| \frac{k - k'}{k + k'} \right|^{\frac{i}{a_B} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k'} \right)} \times \right. \\ &\left. \times {}_2F_1 \left( \frac{i}{ka_B}, 1 - \frac{i}{k' a_B}, 2, \frac{4kk'}{(k + k')^2} \right) \right\}, \end{aligned}$$

где  ${}_2F_1(\alpha, \beta, \gamma; z)$  — гипергеометрическая функция. Интеграл  $I_{k_1, k'_0}^G$  расходится при  $k' \rightarrow k$ . Однако с

учетом квадрата разности энергий в числителе выражения под суммой (37) эта сумма сходится, так как отношение

$$\frac{(E_{k'} - E_k)^2}{(k' - k)^2} = \left(\frac{\hbar^2}{2\mu}\right)^2 (k' + k)^2 \quad (60)$$

уже не имеет особенности. Сокращение квадратов  $(k' - k)^2$  в числителе и знаменателе позволяет выполнить преобразование с появлением дополнительной дельта-функции

$$\frac{1}{(E_{k'} - E_k)^2 + (\hbar/\tau)^2} = \frac{\pi\tau}{\hbar} \delta(E_{k'} - E_k). \quad (61)$$

Из-за этой дельта-функции аргументы  $k, k'$  функции  $f(k, k')$  становятся равными, что существенно упрощает ее вид в силу тождества

$${}_2F_1(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\gamma - \alpha - \beta)}{\Gamma(\gamma - \alpha)\Gamma(\gamma - \beta)}, \quad (62)$$

справедливого при  $\text{Re}(\gamma) > \text{Re}(\alpha + \beta)$ . Для разности гипергеометрических функций получаем

$$\begin{aligned} & {}_2F_1\left(-\frac{i}{ka_B}, 1 + \frac{i}{k'a_B}, 2, 1\right) - \\ & - {}_2F_1\left(\frac{i}{ka_B}, 1 - \frac{i}{k'a_B}, 2, 1\right) = \\ & = -\frac{2i}{ka_B} \frac{1}{1 + \frac{1}{k^2 a_B^2}} \frac{1}{\left|\Gamma\left(1 + \frac{i}{ka_B}\right)\right|^2} = \\ & = -\frac{2i}{\pi} \frac{\text{sh}(\pi/ka_B)}{1 + (ka_B)^{-2}}, \quad (63) \end{aligned}$$

так как

$$\left|\Gamma\left(1 + \frac{i}{ka_B}\right)\right|^2 = \frac{\pi/ka_B}{\text{sh}(\pi/ka_B)}.$$

В итоге имеем

$$f(k, k) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{(ka_B)^2 + 1}}. \quad (64)$$

Видно, что величина  $f(k, k)$  отлична от нуля только при учете кулоновского взаимодействия, для свободной электрон-дырочной пары, для которой  $a_B \rightarrow \infty$ , эта величина стремится к нулю и баллистический фототок исчезает.

## ЛИТЕРАТУРА

1. В. И. Белиничер, Б. И. Стурман, *Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии*, УФН **130**, 415 (1980).
2. V. L. Alperovich, V. I. Belinicher, V. N. Novikov, and A. S. Terekhov, *Photogalvanic Effects Investigation in Gallium Arsenide*, *Ferroelectrics* **45**, 1 (1982).
3. В. Л. Альперович, В. И. Белиничер, А. О. Минаев, С. П. Мощенко, А. С. Терехов, *Баллистический фотогальванический эффект на межзонных переходах в арсениде галлия*, ФТТ **30**, 3111 (1988).
4. В. И. Белиничер, Е. Л. Ивченко, Б. И. Стурман, ЖЭТФ **83**, 649 (1982).
5. Б. И. Стурман, В. М. Фридкин, *Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии и родственные явления*, Наука, Москва (1992) [В. I. Sturman and V. M. Fridkin, *The Photovoltaic and Photorefractive Effects in Noncentrosymmetric Materials*, Gordon and Breach Science Publishers (1992)].
6. E. L. Ivchenko, *Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures*, Alpha Science International, Harrow, UK (2005).
7. Б. И. Стурман, *Баллистический и сдвиговый токи в теории фотогальванического эффекта*, УФН **190**, 441 (2020).
8. Z. Dai and A. M. Rappe, *First-Principles Calculation of Ballistic Current from Electron-hole Interaction*, *Phys. Rev. B* **104**, 235203 (2021).
9. Zhenbang Dai and A. M. Rappe, *Recent Progress in the Theory of Bulk Photovoltaic Effect*, *Chem. Phys. Rev.* **4**, 011303 (2023).
10. Fenggong Wang and A. M. Rappe, *First-Principles Calculation of the Bulk Photovoltaic Effect in KNbO<sub>3</sub> and (K,Ba)(Ni,Nb)O<sub>3-δ</sub>*, *Phys. Rev. B* **91**, 165124 (2015).
11. L. Z. Tan, F. Zheng, S. M. Young, F. Wang, S. Liu, and A. M. Rappe, *Shift Current Bulk Photovoltaic Effect in Polar Materials – Hybrid and Oxide Perovskites and Beyond*, *npj Computational Materials* **2**, 16026 (2016).
12. A. M. Cook, B. M. Fregoso, F. De Juan, S. Coh, and J. E. Moore, *Design Principles for Shift Current Photovoltaics*, *Nat. Commun.* **8**, 14176 (2017).

13. B. M. Fregoso, T. Morimoto, and J.E. Moore, *Quantitative Relationship Between Polarization Differences and the Zone-Averaged Shift Photocurrent*, Phys. Rev. B **96**, 075421 (2017).
14. Chong Wang, Xiaoyu Liu, Lei Kang, Bing-Lin Gu, Yong Xu, and Wenhui Duan, *First-Principles Calculation of Nonlinear Optical Responses by Wannier Interpolation*, Phys. Rev. B **96**, 115147 (2017).
15. J. Ibanez-Azpiroz, S. S. Tsirkin, and I. Souza, *Ab initio Calculation of the Shift Photocurrent by Wannier Interpolation*, Phys. Rev. B **97**, 245143 (2018).
16. Bumseop Kim, Jeongwoo Kim, and Noejung Park, *First-Principles Identification of the Charge-Shifting Mechanism and Ferroelectricity in Hybrid Halide Perovskites*, Sci. Rep. **10**, 19635 (2020).
17. Ruixiang Fei, Liang Z. Tan, and A. M. Rappe, *Shift-Current Bulk Photovoltaic Effect Influenced by Quasiparticle and Exciton*, Phys. Rev. B **101**, 045104 (2020).
18. T. Barik and J. D. Sau, *Nonequilibrium Nature of Nonlinear Optical Response: Application to the Bulk Photovoltaic Effect*, Phys. Rev. B **101**, 045201 (2020).
19. Yang-Hao Chan, D. Y. Qiu, F. H. da Jornada, and S. G. Louie, *Giant Exciton-Enhanced Shift Currents and Direct Current Conduction With Subbandgap Photo Excitations Produced by Many-Electron Interactions*, PNAS **118**, e1906938118 (2021).
20. A. M. Schankler, Lingyuan Gao, and A. M. Rappe, *Large Bulk Piezophotovoltaic Effect of Monolayer 2h-MoS<sub>2</sub>*, J. Phys. Chem. Lett. **12**, 1244 (2021).
21. N. T. Kanera, Yadong Weib, Ali Razad, Jianqun Yangb, Xingji Lib, Weiqi Lia, YongYuan Jianga, and Wei Quan Tian, *First Principles Calculations of Charge Shift Photocurrent in vdWs Slide Double Layered 2D h-BN and  $\beta$ -GeS Homostructures*, J. Phys. Chem. Solids **169**, 110887 (2022).
22. J. Krishna, P. Garcia-Goiricelaya, F. de Juan, and J. Ibanez-Azpiroz, *Understanding the Large Shift Photocurrent of WS<sub>2</sub> Nanotubes: A Comparative Analysis With Monolayers*, Phys. Rev. B **108**, 165418 (2023).
23. Chen Hu, Mit H. Naik, Yang-Hao Chan, Jiawei Ruan, and S. G. Louie, *Light-Induced Shift Current Vortex Crystals in Moiré Heterobilayers*, PNAS **120**, e2314775120 (2023).
24. Penghao Zhu and A. Alexandradinata, *Anomalous Shift and Optical Vorticity in the Steady Photovoltaic Current*, arXiv:2308.08596v3 [cond-mat.mes-hall] 29 Apr 2024.
25. В. И. Шелест, М. В. Энтин, *Фотогальванический эффект при учете электрон-дырочного взаимодействия*, ФТТ **13**, 312 (1979).
26. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика. Нерелятивистская теория*, Наука, Москва (1989).
27. A. G. Aronov and G. E. Pikus, *The Anisotropic Electrooptical Effects and the Raman Scattering*, Proc. Intern. Conf. Phys. Semicond. (Moscow, USSR, 1968), Publishing House «Nauka», Leningrad, Vol. 1, p. 390.
28. R. Winkler, *Spin-Orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems*, Springer, Berlin, Heidelberg (2003).
29. P. O. Löwdin, *A Note on the Quantum-Mechanical Perturbation Theory*, J. Chem. Phys. **19**, 1396 (1951).
30. W. Gordon, *Zur Berechnung Der Matrizen Beim Wasserstoffatom*, Ann. Phys. (Leipzig) **2**, 1031 (1929).
31. V. Véniard and B. Piraux, *Continuum-Continuum Dipole Transitions in Femtosecond-Laser-Pulse Excitation of Atomic Hydrogen*, Phys. Rev. A **41**, 4019 (1990).
32. Y. Komninos, T. Mercouris, and C.A. Nicolaides, *Structure and Calculation of Field-Induced Free-Free Transition Matrix Elements in Many-Electron Atoms*, Phys. Rev. A **86**, 023420 (2012).
33. R. J. Elliott, *Intensity of Optical Absorption by Excitons*, Phys. Rev. **108**, 1384 (1957).

34. E. M. Baskin, M. D. Bloch, M. V. Entin, and L. I. Magarill, *Current Quadratic in Field and Photogalvanic Effect in Crystals Without Inversion Centre*, Phys. Stat. Sol. (b) **83**, K97 (1977).
35. N. V. Leppenen, E. L. Ivchenko, and L. E. Golub, *Sommerfeld Enhancement Factor in Two-Dimensional Dirac Materials*, Phys. Rev. B **103**, 235311 (2021).
36. Е. Л. Ивченко, Г. Е. Пикус, Р. Я. Расулов, *Линейный фотогальванический эффект в полупроводниках  $A_3B_5$  р-типа. Сдвиговый вклад*, ФТТ **26**, 3362 (1984).
37. Ю. Б. Лянда-Геллер, Р. Я. Расулов, *Линейный фотогальванический эффект в полупроводниках  $A_3B_5$  р-типа. 2. Баллистический вклад*, ФТТ **27**, 945 (1985).
38. G. V. Budkin and S. A. Tarasenko, *Thermal Generation of Shift Electric Current*, New J. Phys. **22**, 013005 (2020).
39. J. L. Madańczyk and M. Trippenbach, *Singular Part of the Hydrogen Dipole Matrix Element*, J. Phys. A: Math. Gen. **22**, 2369 (1989).
40. N. V. Leppenen and L. E. Golub, *Linear Photogalvanic Effect in Surface States of Topological Insulators*, Phys. Rev. B **107**, L161403 (2023).